JA 3232413 JCT 1987

BEST AVAILABLE COPY

(54) SEMICONDUCTOR MANUFACTURING DEVICE

(11) 62-232923 (A)

(43) 13.10.1987 (19) JP

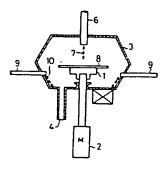
(21) Appl. No. 61-76364 (22) 2.4.1986

(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) KATSUHIKO SUZUKI

(51) Int. Cl⁴. H01L21/30,B05C11/08,G03F7/16

PURPOSE: To enhance washing effect in a cup, by installing medicine_liquiddipping nozzles on the side wall of the cup and mounting a supersonic vibrator. which is for applying supersonic oscillation to the cup, so that waste liquid of resists attached to the inner wall of the cup is easily dissolved.

CONSTITUTION: Resist 7 are dipped on a wafer 8 placed on a wafer chuck 1, and a resist thin film is formed by a centrifugal force on the wafer 8. Then, medicine liquid dipping nozzles 9 for washing the inside of the cup 3 are installed on the side planes of the cup 3. A supersonic vibrator 1 is mounted for applying supersonic vibration to the cup 3. Thus, waste liquid of resists hardened and attached to the inside of the cup 3 is easily dissolved, together with the washing liquid 10, and exhausted from a waste resist port 4 on the bottom part of the cup 3, so that effective washing is performed.



BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-232923

@Int_Cl.4

顋 人

70出

識別記号

庁内望理番号

匈公開 昭和62年(1987)10月13日

H 01 L B 05 C G 03 F 21/30 11/08 7/16

Z - 7376 - 5F

6804-4F A-7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称 半導体製造装置

> 昭61-76364 创特

昭61(1986)4月2日 经出 頭

者 給 木 克 彦 ②発 明 三菱電機株式会社 稲沢市菱町1番地 三菱電機株式会社稲沢以作所内

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

外2名 増雄 弁理士 大岩 30代 理 人

1. 発明の名称

半两体製造装置

2. 特許請求の範囲

回妘するウェハチャックと、このウェハチャッ クを包囲するカップとを始え、前記ウェハチャッ ク上に載置されたウェハ上にレジストを滴下し、 遊心力により前記ウェハ上にレジスト邴颢を形成 する半導体製造装置において、前記カップの傾面 にカップ内を洗浄処理するための築液滴下ノズル を婚えるとともに、前記カップに超音波振動を加 える紹音波発振器子を備えたことを特徴とする半 海体製造装置。

3. 強明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、回転遠心力によりウェハ上にレジ スト荷膜を形成する半導体製造装置に関するもの である。

〔従来の技術〕

従来のこの種の半導体製造装置として、例えば

55.3 図に示すものがある。 (特別四59-829 7 5 号公银,特网昭 6 0 - 8 5 5 2 4 号公银,実

第3図において、1はウェハチャックで、モー ク2の軸端に揮剤されている。3は前記ウェハチ ャック1を包囲しているカップ、4はこのカップ 3 の底部に設けられたレジスト廃液口、5 は同じ くカップ3の底部に設けられた排気口である。 6 は前記カップ3の上部に設けられたノズルで、ウ ェハチャック1の中央に戴置され、ウェハチャッ ク1と同期して回転するウェハ8上にレジスト7 を消下する。

上記のように構成された半導体製造装置は、モ ータ2の緊動によりウェハチャック1とともにウ ェハ8を回収させ、ノズル6からウェハ8上に滴 下されたレジストフを遠心力により外方へ拡散し、 ウェハ8面に均一な薄膜を形成する。この際、ウ ェハ8の外周綴から飛散したミスト状のレジスト 7 はカップ3の内壁に沿って流れ落ち、レジスト 魔波口4から排出され、またミスト状の飛散した

BEST AVAILABLE COPY

特開昭62-232923 (2)

レジスト 7 がウェハ 8 に付着しないように排気口 5 から捩気を行う。

[発明が解決しようとする問題点]

上記のように構成した従来の半端体製造装置は、 オガレジストの粘度が比较的高く、減弱性が低い ため時間とともに配化したレジスト魔液がカップ 3 の側面や底面に付着し易い。このため、カップ 3 内の魔液の均一性が優たれずウェハ8の塗布性 能が低下するため、一般に一日1回程度カップ3 を交換し、洗浄する必要があった。

この発明は、上記の問題点を除去するためになされたもので、カップ内型に固着したレジスト廃液を容易に溶解し、カップ内の洗浄効果を高めた半導体製造装置を得ることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る半導体製造装置は、カップの仰面にカップ内に硬化付着したレジスト廃液を溶設して洗浄する 蒸液滴下ノズルを設けるとともに、カップに超音波最弱を加える超音波発展弦子を増えたものである。

上記のようにカップ3に超音波発展業子11を取り付け、カップ3内に洗浄液10を滴下するとともに、カップ3に超音波振動を加えることにより超音波洗浄の原理により、カップ3内に硬化付着したレジスト烧液は容易に溶融し、洗浄液10とともにカップ3底部のレジスト砕液口4から排出され、効率よく洗浄が行われる。

なお、洗浄液 1 0 としては、例えばトリクレン 等の有拠溶剤を使用し、超音波発展周波数として は、10~1000 K H z にすることにより、良 好な洗浄効果を得ることができる。

(発明の効果)

(作用)

〔 実 施 例 〕

へのレジスト塗布作業が向上し、かつカップの保 守コストが安価になる等の効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の半退体製造装置の一実施例 を示す断面図、第2図はこの発明の他の実施例を 示す断面図、第3図は従来の半選体製造装置の一 例を示す断面図である。

図において、1はウェハチャック、2はモータ、3はカップ、4はレジスト廃板口、6はノズル、7はレジスト、8はウェハ、9は築液滴下ノズル、10は洗浄液、11は超音波発展素子である。

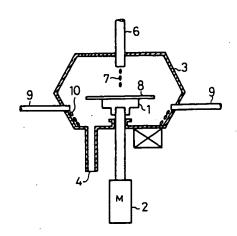
なお、各図中の同一符号は同一または相当部分 を示す。

代理人 大 岩 增 雄 (外2名)

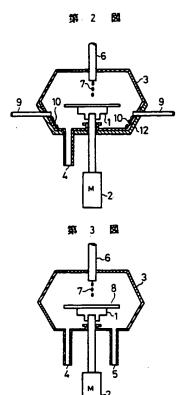
BEST AVAILABLE COPY

特開昭62-232923 (3)

X



- 1:ウェハチャック
- 2:モータ
- 4:レシスト廃液ロ
- 6:ノズル
- 7: レジスト 8: ウェハ
- 9: 茶版値下ノズル
- 10:洗净液 11:超音波発振素子



秋 補 正 書 (ti允)

年 61 12 23

特許庁長官殿

!. 事件の表示

特顧昭 61-?6364 号

2. 発明の名称 半導体製造装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住 所

名 称 (601) 三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4.代 理 人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住 所

三菱電機株式会社内

(7375) 弁理士 大 岩 増 雄 (達格先03(213) 3421特許部)



5. 補正の対象

図飾

6. 補正の内容

第1図、第2図を別紙のように補正する。

以 上

特開昭62-232923 (4)

BEST AVALLAL COLY

